

# Reporte de la practica 3 – Memorias Ram

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

Fecha: 24/11/2023

La presente práctica se centra en la evaluación de diversos módulos de memoria RAM, con el objetivo de comprender su impacto en el rendimiento de diferentes equipos de cómputo. La memoria RAM, o Random Access Memory, es esencial para el almacenamiento temporal de datos que los procesadores necesitan para ejecutar tareas de manera eficiente.

En este estudio, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas de diferentes módulos de RAM en una variedad de configuraciones de sistemas informáticos. La investigación aborda la diversidad de requisitos y demandas de rendimiento presentes en entornos computacionales contemporáneos.

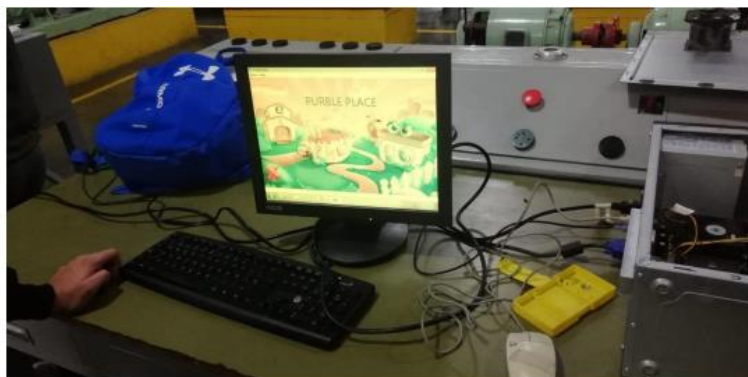
La elección y compatibilidad de la memoria RAM pueden tener un impacto significativo en la velocidad de procesamiento, la capacidad multitarea y la estabilidad general de un sistema. La metodología de la práctica incluyó la instalación de varios tipos de módulos de memoria RAM en diferentes equipos, seguida de pruebas de rendimiento que abarcaron desde tareas cotidianas hasta cargas de trabajo más intensivas.

## Practica

1. Comenzamos por comprobar que el equipo funcionara



2. Después fuimos probando varios módulos para probar su funcionamiento



3. Las memorias utilizadas fueron:

a) Kingston KVR667D2N5/2G

Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 2 GB Velocidad: 667 MHz Latencia CAS: CL5 Voltaje: 1.8 V Configuración de pines: 240 pines Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



b) Kingston KVR667D2N5/1G

Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 1 GB Velocidad: 667 MHz Latencia CAS: CL5 Voltaje: 1.8 V Configuración de pines: 240 pines Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



c) Kingston KTC-EN133/128

Tipo de memoria: SDRAM Capacidad: 128 MB Velocidad: 133 MHz Voltaje: 3.3 V Configuración de pines: 168 pines Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



d) ADATA DDR2 667(5) 512MX8

Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 4 GB (en módulos de 512 MB) Velocidad: 667 MHz Latencia CAS: CL5 Voltaje: 1.8 V Configuración de pines: 240 pines Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



e) Nanya PC2-5300U-555-1

Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 512 MB Velocidad: 667 MHz (PC2-5300U) Latencia CAS: CL5 Voltaje: 1.8 V Configuración de pines: 240 pines Organización de chips: 1Rx8 Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



f) ADATA DDR2 667(5) 1GX8

Tipo de memoria: DDR2 SDRAM Capacidad: 1 GB Velocidad: 667 MHz Latencia CAS: CL5 Voltaje: 1.8 V Configuración de pines: 240 pines Organización de chips: 1GX8 Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



g) Samsung M366S1723CTS

Tipo de memoria: DDR SDRAM Capacidad: 128 MB Velocidad: 133 MHz Latencia CAS: CL3 Voltaje: 2.5 V Configuración de pines: 184 pines Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)



h) Apacer 128MB UNB PC133 CL3

Tipo de memoria: SDRAM Capacidad: 128 MB Velocidad: 133 MHz Latencia CAS: CL3 Voltaje: 3.3 V Configuración de pines: 168 pines Factor de forma: DIMM (dual in-line memory module) Tecnología de memoria: Non-ECC (error-correcting code)

